

電気回路網の安定性について

早大 理工 松本 隆 横浜市大 文理 一楽重雄
 徳大 工 川上 博 加州大バークレー L.O. Chua

抵抗 n -port

n_R 個の抵抗と n 個の端子対 (port と呼ぶ) からなる電気回路網を (抵抗) n -port という。 v_R 及び v_p を、各々、抵抗及び p port の電圧とし、 i_R 及び i_p を、各々、抵抗及び p port の電流とする。 $v = (v_R, v_p)$ 、 $i = (i_R, i_p)$ とすると、 $(v, i) \in \mathcal{L} \cap \mathcal{K} \triangleq \Sigma$ を満たさなければならぬ、但し、 \mathcal{L} は抵抗特性を表わす。 $\mathbb{R}^b \times \mathbb{R}^b$ の $2b - n_R$ 次元 C^1 多様体、 \mathcal{K} は Kirchhoff space で、 b 次元線形部分空間である。 ($b = n_R + n$)。 Σ を n -port \mathcal{N} の configuration space という。

面白い例をいくつかあげてみる。図 1 (a) は抵抗 r_1 と r_2 と port p と一つからなる回路で、 1-port と呼ばれる。 R_1 と R_2 の特性を与えた時、 Σ はどのようなものになるか、また port から見た時、どのような電圧・電流特性を持つか考えてみる。図 1 (b) の左側は R_1, R_2 の 8 つの組合せが示されている。

$i_{Rk} = f_{Rk}$ あるいは $v_{Rk} = g_{Rk}(i_{Rk})$, $k = 1, 2$, である。

Σ を描くことは技術的に少し容易しくないのよ、 Σ の (v_p, i_p) 空間への射影、すなわち、port から見た電圧・電流特性を示したのが図1(b)の右側である。図2は norator と呼ばれるもので、 $v_p - i_p$ 特性は全空間 \mathbb{R}^2 となる。図3は nullator と呼ばれ、 $v_p - i_p$ 特性は原点のみである。図4では、 R_1 及び R_2 の特性が (b) 及び (c) で与えられていると $v_p - i_p$ 特性は (d) の様になる。図5で $i_{pk} = f_{Rk}(V_{Rk})$, $k=1, 2$, とおくと、 $v_p - i_p$ 特性は $v_p = f_{R_1}(p)$, $i_p = f_{R_2}(p)$, $p = v_{R_1} = v_{R_2}$, なるパラメータ表示になる。逆に言えば、 $v_p - i_p$ 特性が $v_p = f_1(p)$, $i_p = f_2(p)$, p はパラメータで表現される 1-port は、 R_1, R_2 の特性を各々 $v_{Rk} = f_k(v_{Rk})$ とする事により図5(a)の回路で実現される。尚この場合 Σ は self intersection を持たず、任意の C^1 関数 f_{Rk} , $k=1, 2$, に対して、1次元 C^1 多様体となる。図6では、 R_1, R_2 を (a), (b) の様に与えると $v_p - i_p$ 特性は同図(d)の様になる。

定義 Σ が n 次元 C^1 多様体の時、 N を正則 (regular) n -port という。

$\dim \Lambda = 2b - n_R$, $\dim K = b$ であるから Λ 亦 K であるならば N は正則である。 Λ 亦 K を手ェッするには次の様に可れ
 ばよい。 N のひとつの木を \mathcal{N} とし、 \mathcal{L} を補木とする。 B

及び Q を各々, \mathcal{O} に関する基本ルーフ行列及び基本カットセツト行列とすると,

$$B = [1 \mid B_{\sigma}], \quad Q = [-B_{\sigma}^T \mid 1] \quad (1)$$

の形で与えられる。 Λ は $2b - n_R$ 次元 C^1 多様体であるから, 各点 $(v_0, i_0) \in \Lambda$ に対して, 近傍 $U \subset \mathbb{R}^b \times \mathbb{R}^b$ と C^1 関数 $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n_R}$ があって

$$\Lambda \cap U = f^{-1}(0) \quad (2)$$

$\text{rank}(Df)(v, i) = n_R, (v, i) \in \Lambda \subset U$ が成立する。 $K = \text{Ker } B \times \text{Ker } Q$ だから, $\Sigma \cap U$ は $Bv = 0, Qi = 0, f(v, i) = 0$ で与えられる。今,

$$\mathcal{F}(v, i) = \left[D_{v_{\sigma}} f - (D_{v_{\mathcal{L}}} f, B_{\sigma}; D_{i_{\mathcal{L}}} f + (D_{i_{\sigma}} f) B_{\sigma}^T) \right]_{(v, i)} \quad (3)$$

とおくと,

$$\Lambda \cap K \iff \begin{array}{l} \text{各点 } (v, i) \in \Sigma \text{ に対して} \\ \text{rank } \mathcal{F}(v, i) = n_R \end{array}$$

となる。但し $v = (v_{\mathcal{L}}, v_{\sigma}), i = (i_{\mathcal{L}}, i_{\sigma})$ 。

抵抗特性 Λ が

$$\Lambda = \{ (v, i) \mid (v_R, i_R) \in \Lambda_R \} \quad (4)$$

で与えられる場合も数多くある。この時, (2) の f は (v_p, i_p) に依存しない。今 $U_R = U \cap \mathbb{R}^{n_R} \times \mathbb{R}^{n_R}, f_R(v_R, i_R) = f(v, i)$ とおく。又, $\pi_R' : \mathbb{R}^b \times \mathbb{R}^b \rightarrow \mathbb{R}^{n_R} \times \mathbb{R}^{n_R}$ を射影

$$\pi_R'(v, i) = (v_R, i_R) \quad (5)$$

を定義し,

$$\pi_R = \pi_R' \circ \gamma \quad (6)$$

とおく。但し, $\gamma: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^b \times \mathbb{R}^b$ は inclusion である。次に

電圧, 電流を

$$v = (v_{R\ell}, v_{P\ell}, v_{R\sigma}, v_{P\sigma}), \quad i = (i_{R\ell}, i_{P\ell}, i_{R\sigma}, i_{P\sigma})$$

と分割し, (1) の B_{σ} を

$$B_{\sigma} = \begin{bmatrix} B_{RR} & B_{RP} \\ B_{PR} & B_{PP} \end{bmatrix}$$

と分割する。A が (4) を与えられる時, 次が成立する:

$$\Lambda \text{ 正定} \iff \begin{array}{l} \text{各点 } (v_R, i_R) \in \pi_R(\Sigma) \text{ に対して} \\ \text{rank } \mathcal{F}_R(v_R, i_R) = n_R \end{array}$$

但し,

$$\mathcal{F}_R(v_R, i_R) = \begin{bmatrix} D_{v_{R\sigma}} f_R - (D_{v_{R\ell}} f_R) B_{RR}^{-1} - (D_{v_{P\ell}} f_R) B_{RP} \\ D_{i_{R\ell}} f_R + (D_{i_{R\sigma}} f_R) B_{RR}^T - (D_{i_{P\sigma}} f_R) B_{PR}^T \end{bmatrix}$$

先にあげた例では, 図 1 の場合, (vi) を除いて全て, Λ 正定である。図 2, 3, 4, 6 では Λ 正定, 図 5 では Λ 正定 とはならない。

安定性

抵抗特性 Λ は, 種々の物理的パラメータ (例えば温度) に

依存する。ここでは Λ が少し変、 Σ が定性的に変るか変らないかを考える。実際に用いられる回路では、 Λ は常に小さな擾動を受けているので、それと共に Σ が急激に変、 Σ は困る。また、回路網の計算機シミュレーションに於て計算誤差は擾動と考えられるので、数値的に安定な数学モデルではないと困る。

さて、 Λ が少し動くという事実を定式化する。 M を \mathbb{R}^n の C^1 多様体とし、 $C^1(M; \mathbb{R}^n)$ を M から \mathbb{R}^n への C^1 関数の全体とする。 $F \in C^1(M; \mathbb{R}^n)$ とし、

$$\mathcal{U}(F; \varepsilon) = \left\{ G: M \rightarrow \mathbb{R}^n \left| \begin{array}{l} G \in C^1(M, \mathbb{R}^n) \\ \|F(x) - G(x)\| + \|(dF)_x - (dG)_x\| \\ < \varepsilon(x), \quad x \in M \end{array} \right. \right\}$$

を考える。但し、 $\varepsilon: M \rightarrow \mathbb{R}^+$ は任意の正值連続関数。

$C^1(M; \mathbb{R}^n)$ の強 C^1 位相は上の様な集合から生成される。

この位相に関して $\text{Emb}^1(M; \mathbb{R}^n)$ は開なので、次の様な定義を可る。

定義 $\gamma_M: M \rightarrow \mathbb{R}^n$ を inclusion とし、 $\mathcal{U}(\gamma_M)$ を十分小さな γ_M の近傍で、 $\mathcal{U}(\gamma_M)$ の全ての要素が M の C^1 embedding である様に可る。この時、 Λ の擾動 $\hat{\Lambda}$ を $\hat{\Lambda} = G(\Lambda)$, $G \in \mathcal{U}(\gamma_M)$, と定義可る。

次の結果では、技術的理由から、 Λ が閉である事を仮定可

る。電気回路では N は殆んど全ての場合閉である。

結果 N が閉である抵抗 m -port N を考える。 $N \cap K \neq \emptyset$ とする。

(i) もし N と K があれば, N は正則, として, 次の意味で安定: N の十分小さい任意の擾動 \hat{N} に対して, $\hat{\Sigma} = \hat{N} \cap K$ は n 次元 C^1 多様体であり続ける。実際, Σ と $\hat{\Sigma}$ は C^1 diffeo.

(ii) もし N と K があれば, N は次の意味で不安定:

(a) Σ が n 次元多様体でない場合, N の擾動 \hat{N} があつて, $\hat{\Sigma}$ は n 次元多様体となる。

(b) Σ が n 次元多様体である場合, N の擾動 \hat{N} があつて, $\hat{\Sigma}$ は $(n+k)$ 次元多様体を含む, $k > 0$.

上の結果によれば, 安定な m -port は正則なものに限られる。

(ii)(a) を示す際, 回路では $N \cap K = \emptyset$ は意味がないので注意を要する。電圧, 電流が抵抗特性とキルヒホフの法則を同時に満たさなければならぬ。だから, N と K の時, N を少し動かして \hat{N} と K とある場合, $\hat{N} \cap K \neq \emptyset$ を保証しなければならない。そのための, (v, i) を nontransversal intersection とし, その点での $T(v, i)N$ と $T(v, i)K$ を考える。 $T(v, i)N$ を少し回転させると $A(T(v, i)N)$ と $T(v, i)K$ とで与える。但し A は回転を表わす行列。 N を

(v, i) の近くを少し回転させ、他は動かさない様にして得られたものを L_1 とする。又 (v, i) は L_1 と K の transversal intersection になるが、未だ他にも nontransversal intersection が残っているかも知れないし、また、 L_1 を少し動かす事によつて、新しい nontransversal intersection ができてしまったかも知れない。そこで、 L_1 を少し動かした \hat{L} とし \hat{L} と K とできる事を用いる。 L_1 と K は (v, i) で non empty, transversal intersection をもつから少し動かしても non empty intersection を持ち続ける。従つて $\hat{L} \cap K \neq \emptyset$ 。

(ii)(b) で (v, i) を nontransversal intersection とする。この時、ある $k > 0$ に対して

$$\dim (T_{(v,i)} L + T_{(v,i)} K) = 2b - k$$

であるから、

$$\dim (T_{(v,i)} L \cap T_{(v,i)} K) = m + k$$

となり、 k は nontransversality から来る余分の次元である。そこで L を局所的に $T_{(v,i)} L$ の上におしつぶし、他はそのまゝにしておけば、望むものが得られる。

回路擾動による正則 m -port の構成

与えられた m -port N で、 L と K であつたとする。 L を少し動かして \hat{L} とし \hat{L} と K 、 $\hat{L} \cap K \neq \emptyset$ 、とできる事は、先の結

果と同様に示せる。 m -port N に新しい n 個の port をつくって $(m+n)$ -port にする操作を回路擾動と呼ぶ。これに対して \mathcal{L} の擾動を素子擾動と呼ぶ。ここでは、回路擾動による正則 $(m+n)$ -port の構成を考える。

結果 抵抗 m -port N を、 \mathcal{L} 及び K , $\mathcal{L} \cap K \neq \emptyset$, とし、 \mathcal{L} なる場合を考える。任意の木を \mathcal{T} とし、対応する補木を \mathcal{L} とする。 \mathcal{T} の各枝と並列に新しい port をつくり、 \mathcal{L} の各枝と直列に新しい port をつくり、これを \hat{N} と呼ぶ。この時 \hat{N} は $(m+n)$ -port であり、 $\hat{\mathcal{L}} \cap \hat{K} \neq \emptyset$, $\hat{\mathcal{L}}$ 及び \hat{K} , 従って、 \hat{N} は正則、そして安定である。

(注意) 新しい port をつくと、 \mathcal{L} も K も変わる。

証明 \mathcal{T} と並列につく、 k port の枝を \mathcal{T}_1 , \mathcal{L} と直列につくった port の枝を \mathcal{L}_1 とする。 $\hat{\mathcal{T}} = \mathcal{L} \cup \mathcal{T}_1$ は \hat{N} の木となり、 $\hat{\mathcal{L}} = \mathcal{T} \cup \mathcal{L}_1$ は \hat{N} の $\hat{\mathcal{T}}$ に関する補木となる。 \hat{N} の変数を

$$\hat{v} = (v_{\mathcal{T}}, v_{\mathcal{L}_1}, v_{\mathcal{L}}, v_{\mathcal{T}_1}), \quad \hat{i} = (i_{\mathcal{T}}, i_{\mathcal{T}_1}, i_{\mathcal{L}}, i_{\mathcal{T}_1})$$

と分割する。 $(v_0, i_0) \in \mathcal{L} \cap K \neq \emptyset$ に対して

$$\hat{v}_0 = (v_{0\mathcal{T}}, 0, v_{0\mathcal{L}}, v_{0\mathcal{T}_1}), \quad \hat{i}_0 = (i_{0\mathcal{T}}, i_{0\mathcal{L}_1}, i_{0\mathcal{L}}, 0)$$

とおくと

$$(\hat{v}_0, \hat{i}_0) \in \hat{K} \quad (7)$$

となる。これは (\hat{v}_0, \hat{i}_0) が \mathcal{T}_1 を開放、 \mathcal{L}_1 を短絡した事に相当するからである。又、抵抗は付け加えていないから、

$$\hat{\Lambda} = \{(\hat{v}, \hat{i}) \mid (v, i) \in \Lambda\} \quad (8)$$

となり, $(\hat{v}_0, \hat{i}_0) \in \hat{\Lambda}$. (7)(8)より

$$(\hat{v}_0, \hat{i}_0) \in \hat{\Lambda} \cap \hat{K} \neq \emptyset.$$

を得る。さて, \hat{N} の基本ル-フ行列 \hat{B} の主要部 \hat{B}_σ は次の様に与えられる:

$$\hat{B}_\sigma = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & B_\sigma \end{bmatrix} \begin{matrix} v_{\sigma_1} \\ v_\sigma \\ v_{\sigma_2} \end{matrix}$$

次に, $\hat{f}(\hat{v}, \hat{i}) = f(v, i)$,

$$D_{\hat{v}_\sigma} \hat{f} = [D_{v_\sigma} f \mid 0], \quad D_{\hat{v}_\sigma} \hat{f} = [D_{v_\sigma} f \mid 0],$$

$$D_{\hat{i}_\sigma} \hat{f} = [D_{i_\sigma} f \mid 0], \quad D_{\hat{i}_\sigma} \hat{f} = [D_{i_\sigma} f \mid 0].$$

である事に注意すると

$$\hat{J}(\hat{v}, \hat{i}) = [D_{v_\sigma} f \mid D_{v_\sigma} f \mid D_{i_\sigma} f \mid D_{i_\sigma} f] = (Df)(v, i)$$

を得る。従って

$$\text{rank } \hat{J}(\hat{v}, \hat{i}) = n_R$$

となり, $\hat{\Lambda}$ 亦 \hat{K} が従う。

Λ が (4) で与えられる場合は, 加える port 数は少なくて可也。

結果 Λ が (4) で与えられており, $\Lambda \not\subset K$, $\Lambda \cap K \neq \emptyset$, とする。 σ を N の任意の木とし, \mathcal{L} を対応する補木とする。 $\sigma = R_\sigma \cup P_\sigma$, $\mathcal{L} = R_\mathcal{L} \cup P_\mathcal{L}$ と分割する。但し R_σ は木

の抵抗枝, P_{σ} は木の port 枝, 他にも同様な意味を持つ。
 R_{σ} の各枝と並列に port をつくり, R_{ε} の各枝と直列に
port をつる。こうしてできたものを \hat{N} とすると, これは
 $(m+nR)$ -port であって, $\hat{L} \cap \hat{K} \neq \emptyset$, \hat{L} 而 \hat{K} , 従って \hat{N}
は正則, として安定である。

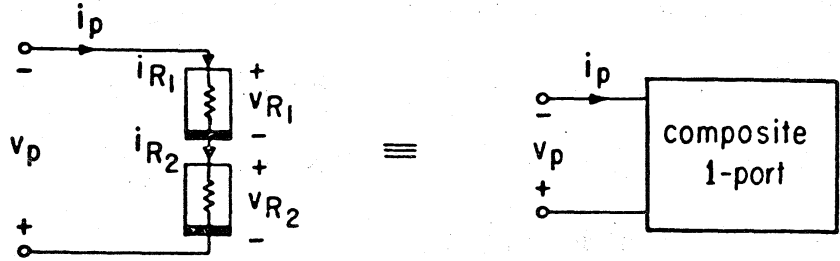
問題 1 $\pi_p' : \mathbb{R}^b \times \mathbb{R}^b \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ を $\pi_p'(v, i) = (v_p, i_p)$
で定義し, $\pi_p = \pi_p' \circ \tau$ とおく。但し $\tau : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}^b \times \mathbb{R}^b$
は inclusion, $\pi_p(\Sigma)$ の安定性を定義し, 調べる事。

問題 2 N_k を m_k -port とする, $k=1, \dots, m$. N_k は
全て L_k 而 K_k を満たすとする。 N_k を互につなぎ合わせて
できる回路を \mathcal{N} とする。 \hat{L} 而 \hat{K} となる十分条件を N_k
の性質のみから調べる事。

[文献]

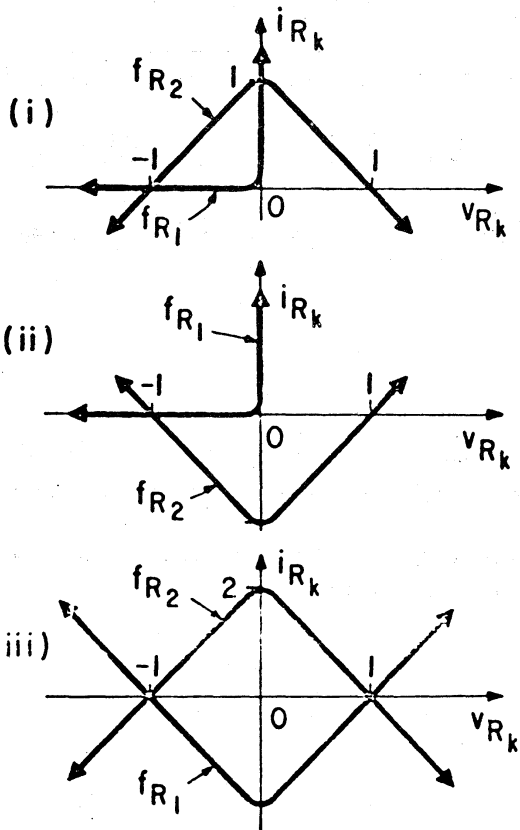
[1] L. O. Chua, T. Matsumoto and S. Ichiraku, Geometric Properties of
Nonlinear Resistive n-Ports, IEEE Trans. Circuits and Systems, to appear

[2] T. Matsumoto, L. O. Chua, H. Kawakami and S. Ichiraku, Geometric
Properties of Nonlinear Dynamic Networks, preprint



(a)

Constitutive relations of R_1 and R_2



Constitutive relation of the composite port

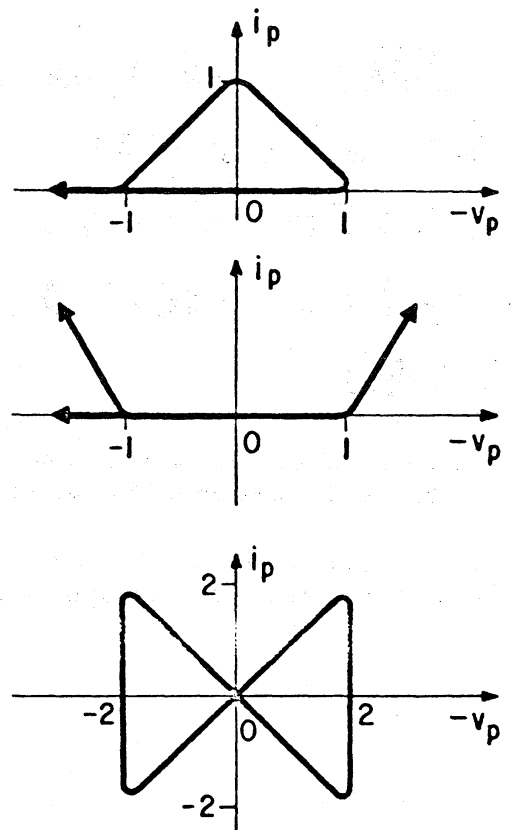
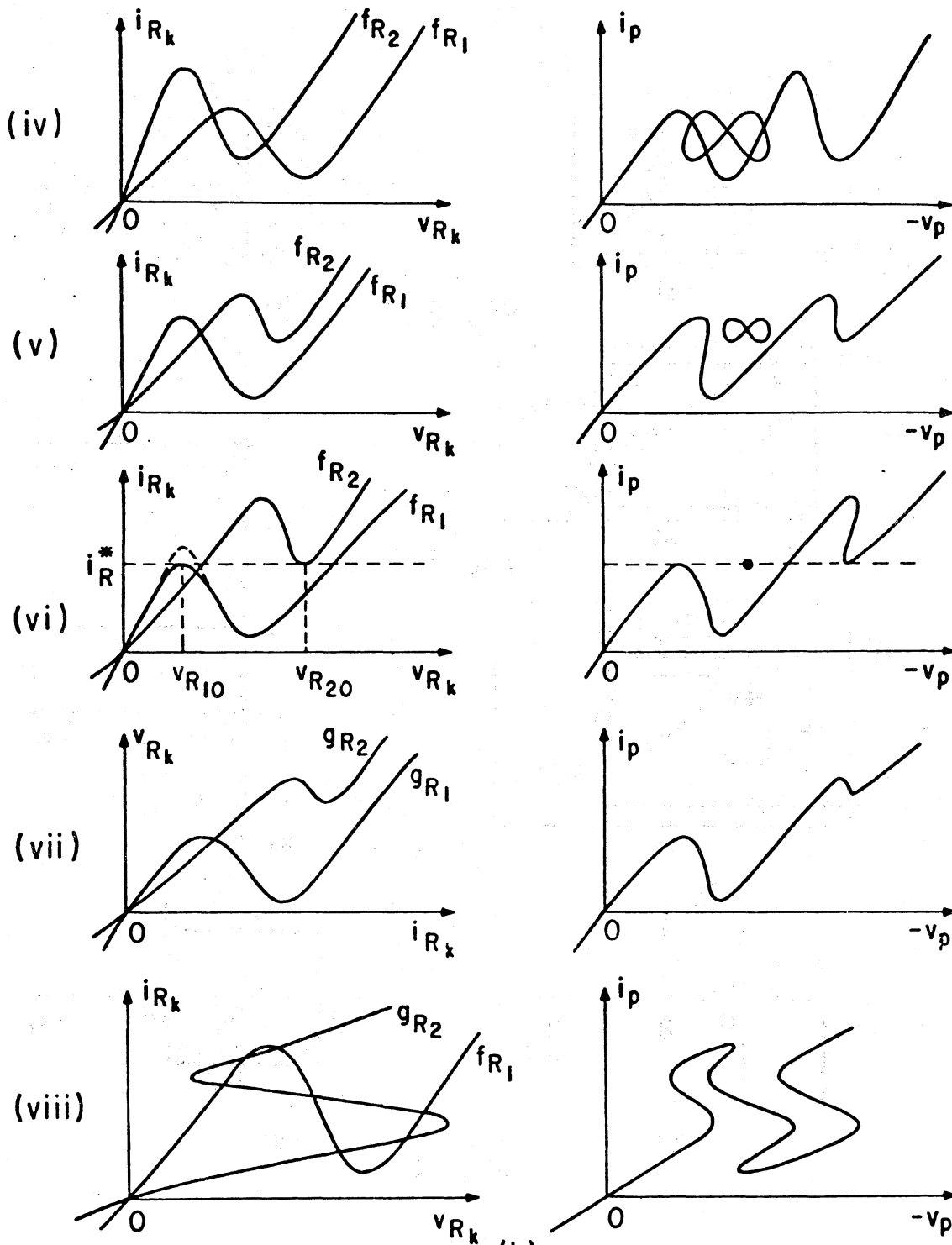


Fig. 1



(b)
Fig. 1

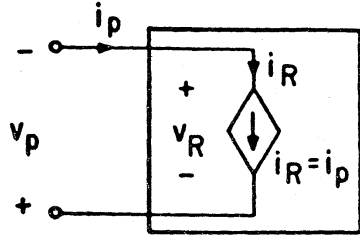


Fig. 2

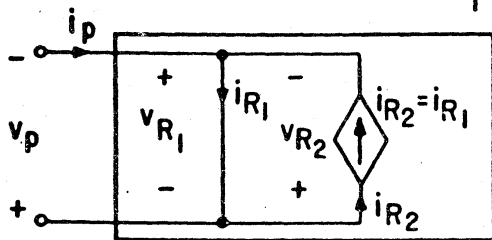
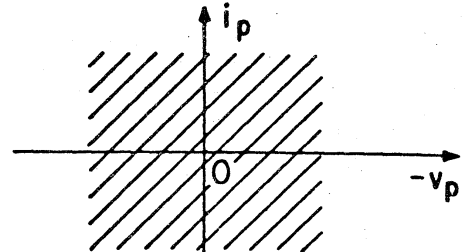
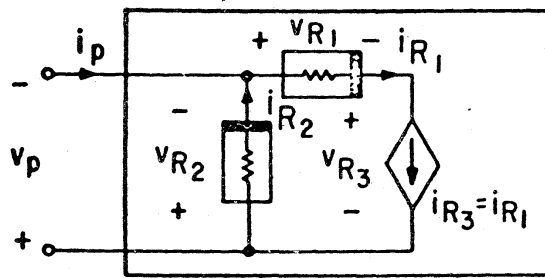
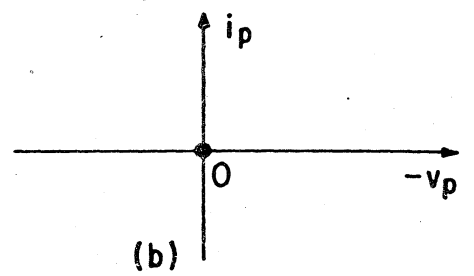
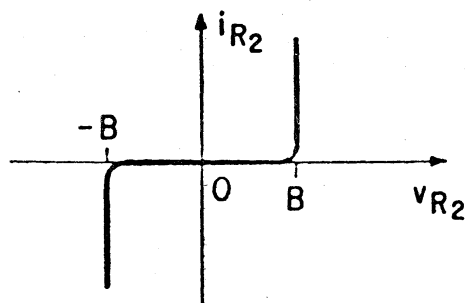
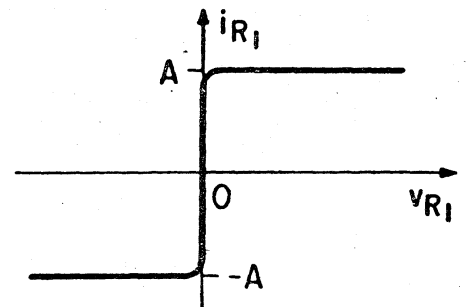


Fig. 3



(a)



(c)

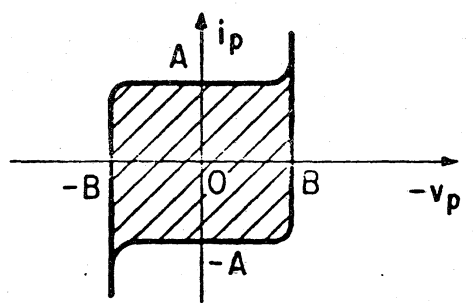


Fig. 4

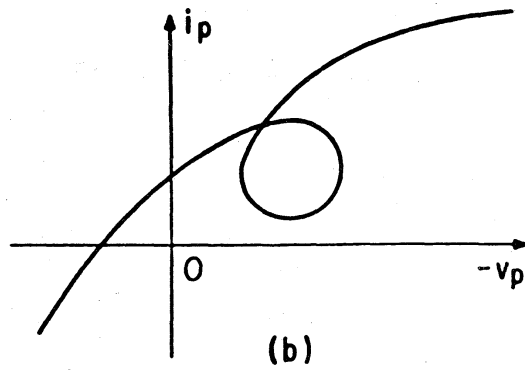
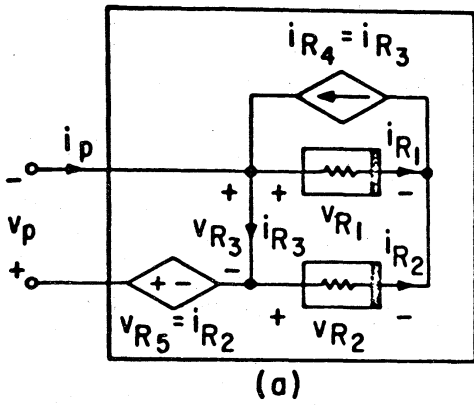


Fig. 5

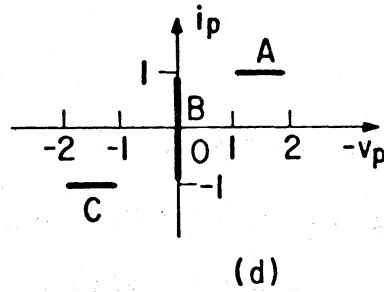
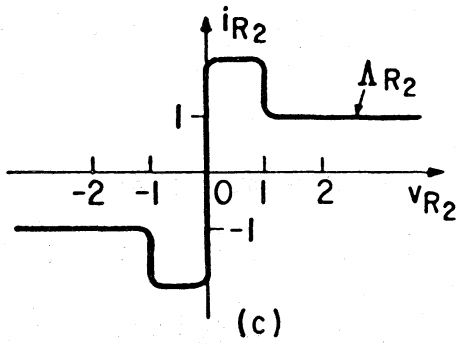
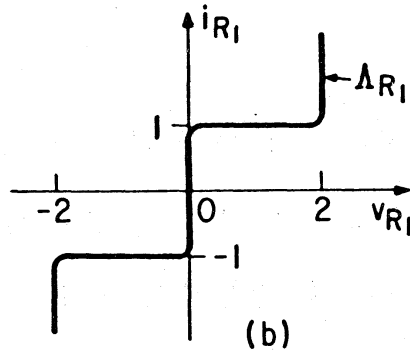
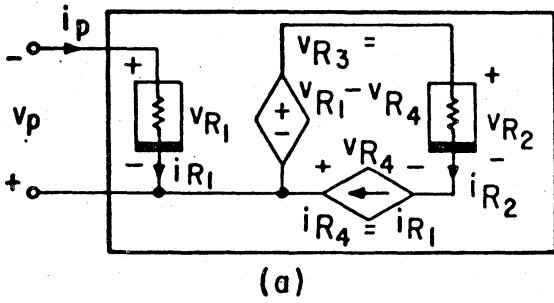


Fig. 6